## トンネル FET の閾値電圧評価法に関する研究

Study on evaluation method for threshold voltage of Tunnel FET

 ○唐鎌亮太<sup>1</sup>, 岸佳佑<sup>1</sup>, 三田梓郎<sup>1</sup>, 山口直弥<sup>1</sup>, 呉研<sup>2</sup>, 高橋芳浩<sup>2</sup>
\* Ryota Karakama<sup>1</sup>, Keisuke Kishi<sup>1</sup>, Shiro Mita<sup>1</sup>, Naoya Yamaguchi<sup>1</sup> Yan Wu<sup>2</sup>, Yoshihiro Takahashi<sup>2</sup>

Abstract: The tunnel length of the Tunnel FET was calculated by simulation and the threshold voltage was derived (TL method). It was confirmed that the threshold voltage derived by the TL method is closer to the threshold voltage derived by the CC method than the SD method and the LE method.

## <u>1. 背景・目的</u>

TFET(Tunneling field effect transistor)はSS(Subthreshold swing)を原理的に低減させる急峻なスイッチングデバ イスとして注目されている.しかしTFETの詳細な物理的メカニズムについては解明されていないことも多く, 閾値電圧の導出方法は確立されていない.一部の報告例ではTFETのドレイン電流はソース・ボディ間のトンネ ル長と相関性があることが分かっており、ゲート電圧の上昇に伴い、トンネル長が飽和し始める点を閾値電圧と している[1].本研究ではシミュレーションによりトンネル長の算出を行い、ドレイン電流との関係性を調べ,閾 値電圧の導出を試みた.また一般的にMOSFETで用いられる閾値電圧評価法をTFETに適用し、閾値電圧の導出 及び比較を行った.

## 2. 結果·考察

Fig. 1に各ゲート酸化膜厚 $d_{ox}$ における、ゲート電圧 $V_G$ に対するトンネル長 W<sub>BT</sub>の変化を示す.酸化膜厚によらず、 $V_G$ の上昇に伴い $W_{BT}$ が一定値に収束 していることがわかる.トンネル長はドレイン電流に強い相関があることか ら、この特性の変曲点より閾値電圧 $V_T$ が導出できると考えられる[1].そこで、 Fig. 2に示すように外挿法を用いることにより $V_T$ の評価を行った[2].本手法

(TL法)により評価された $V_T \delta$ Fig. 2内に示す.結果より,酸化膜厚に拘わらず $V_T$ の評価は可能であり,酸化膜厚と共に $V_T$ が大きくなることを確認した.

ただし、トンネル長を求めるにはデバイスシミュレーションの使用が必須 であり、更にデバイス構造が既知である必要がある。一般的な実デバイスで は詳細なデバイス構造は不明であることから、電気的特性の測定結果から $V_T$ を評価することが実用上非常に重要となる。そこでMOSFETにおいて一般的 に用いられている、定電流法(CC法)、線形外挿法(LE法)、相互コンダク タンス導関数法(SD法)などの $V_T$ 評価法をTFETに適用した結果と、TL法で 評価した結果とを比較した。Fig. 3に各評価法により導出した $V_T$ の結果を示 す.結果より酸化膜厚が厚くなるほどTL法とSD法の差が大きくなることが確 認できた。また全ての酸化膜厚においてLE法とSD法に比べ、CC法により評 価した $V_T$ がTL法による値に近くなることを確認した。



Fig. 1 W<sub>BTBT</sub>-V<sub>G</sub> characteristic







## 参考文献

- Kathy Boucart, Adrian Mihai Ionescu, "A new definition of threshold voltage in Tunnel FETs", Solid-State Electronics2008;52: 1318-23..
- [2] Y. Mori, S. Sato, Y. Omura, A. Chattopadhyay, and A. Mallik, "On the definition Fig. 3 Comparison of threshold voltage of threshold voltage for tunnel FETs", Superlat. & Micros2017;107: 17-27.evaluation methods

1: 日大理工・院(前)・電子, 2: 日大理工・教員・電子